結晶加工と評価技術第 145 委員会 第 105 回研究会

日 時 ： 2006 年 2 月 1 日(水) 10:00－17:00
場 所 ： 弘済会館 4F 菊の間
テーマ ： 歪シリコン技術
世話人 ： 小椋 厚志(明治大学)、上浦 洋一(岡山大学大学院)、酒井 朗(名古屋大学大学院)

＜プログラム＞

10:00-10:30 イントロダクトリートーク
小椋 厚志 (明治大学)

10:30-11:00 酸化濃縮法によるひずみSOI、SGOI (SiGe-On-Insulator)、GOI (Ge-On-Insulator) - MOSFET の作製と電流駆動力の向上
手塚 勉[1]、沼田 敏[1]、入沢 寿史[1]、中払 周[1]、臼田 宏治[1]、平下 紀夫[1]、守山 佳彦[1]、杉山 直治[1]、豊田 英治[2]、宮村 佳児[3]、高木 信一[1,4] (MIRAI-ASET[1]、東芝セラミックス[2]、コマツ電子金属[3]、東京大学大学院[4])

11:00-11:30 高速ＬＳＩ用歪Ｓｉ基板の開発
泉妻 宏治、仙田 剛士、豊田 英二、高野 英明、本臼 正周（東芝セラミクス）

11:30-12:00 歪み SOI 基板技術による CMOS 高性能化
吉見 信 (SOITEC アジア)

12:00-13:30 昼食休憩

13:30-14:00 歪シリコンデバイスの現状 －基板歪技術は使われるか？
杉井 信之 (日立製作所)

14:00-14:30 放射光による歪シリコン系材料の評価
－マイクロ回折法による研究例を中心として－
木村 滋[1]、竹田 晋吾[1]、酒井 朗[2]、望月 省吾[2]、中塚 理[3]、財満 鎭明[2]、小川 正毅[4] ((財)高輝度光科学研究センター[1]、名古屋大学大学院工学研究科[2]、名古屋大学エコトピア科学研究所[3]、名古屋大学先端技術共同研究センター[4])

14:30-15:00 CBEDによるLSI中の歪評価
戸田 昭夫 (ＮＥＣ)

15:00-15:30 休憩

15:30-16:00 ラマン散乱分光による歪みシリコンの評価
中島 信一、三谷 武志 (産業技術総合研究所)

16:00-16:30 シリコンナノ細線中の熱酸化応力誘起とフォノン閉じ込め効果
深田 直樹[1,3], 大島 崇[2], 岡田 直也[2], 木塚 徳志[4], 鶴井 隆雄[5], 伊藤 俊[5], 関口 隆史[1], 村上 浩一[2,3] (物材機構[1], 筑波大院電子･物理工学専攻[2], 筑波大特プロ「ナノサイエンス」[3], 筑波大物質工[4], 東北大金研[5])

16:30-17:00 シリコン熱酸化における原子輸送機構と歪み
影島 博之[1]、秋山 亨[2]、植松 真司[1]、伊藤 智徳[2]
(ＮＴＴ物性科学基礎研究所[1]、三重大学工学部[2])

17:10-18:45 懇親会 桜の間 ： 会費2000円(当日受付にて申し受けます)